



半导体分立器件
LYCS11P150U8 型大功率 P 沟道
场效应晶体管产品手册

济南晶恒电子有限责任公司

V1.0

LYCS11P150U8 型大功率 P 沟道 MOS 场效应晶体管

1 产品概述

LYCS11P150U8 是大功率 P 沟道场效应晶体管之一,采用 VDMOSFET 工艺制造。在整机电子线路中具有放大、开关作用,也可用作动态阻抗和恒流源等。



SMD-0.2 型

2 ZZKK 情况

LYCS11P150U8 型大功率 P 沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品,其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制造、产品检测与供应均满足 ZZKK 要求。

3 特性

可提供 SMD-0.2 金属陶瓷封装。
具有开关速度快、损耗小,输入阻抗高,驱动功耗小安全工作区宽,温度稳定性好的特点。
器件的静电放电敏感度为人体模式 1C 级,1000V。SMD-0.2 型封装的典型重量为 0.45g。

4 可提供质量等级

J 级;
G 级: QZJ840611, Q/RBJ1005QZ。

5 最大额定值

最大额定值见表 1,除另有规定外, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

<div>参数</div> <div>产品型号</div>	P_D^a ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) W	V_{GS} V	I_{DM1} ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) A	I_{DM2} ($T_C=100^{\circ}\text{C}$) A	$R_{th(j-c)}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$	T_j $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$	封装形式
LYCS11P150U8	63	± 20	-11	-7.2	5.0	-55~150	-55~150	SMD-0.2

^a 当 T_C 超过 25°C 时,按 $0.5\text{W}/^{\circ}\text{C}$ 线性降额。

6 主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}\pm3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{\text{GS}}=0\text{V}, I_{\text{D}}=-0.25\text{mA}$	-150	—	—	V
2	阈值电压 ^a	$V_{\text{GS(th)}}$	$V_{\text{DS}}=V_{\text{GS}}, I_{\text{D}}=-0.25\text{mA}$	-2.0	—	-4.0	V
3	导通电阻	$R_{\text{DS(on)}}$	$V_{\text{GS}}=-10\text{V}, I_{\text{D}}=-7.2\text{A}$	—	—	290	mΩ
4	零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{\text{DS}}=-150\text{V}, V_{\text{GS}}=0\text{V}$	—	—	25	μA
5	正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{\text{GS}}=-20\text{V}$	—	—	-100	nA
6	反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{\text{GS}}=20\text{V}$	—	—	100	nA
7	开启延迟时间	$t_{\text{d(ON)}}$	$V_{\text{DD}}=-75\text{V}, V_{\text{GS}}=-10\text{V},$ $I_{\text{D}}=-7.2\text{A}, R_{\text{G}}=6.8\Omega$	—	25	—	ns
	上升时间	t_{r}		—	65	—	ns
	关断延迟时间	$t_{\text{d(OFF)}}$		—	75	—	ns
	下降时间	t_{f}		—	53	—	ns
8	栅电荷	Q_{g}	$V_{\text{DD}}=-100\text{V}, I_{\text{D}}=-7.2\text{A}$ $V_{\text{GS}}=-16\text{V}$	—	29	—	nC
		Q_{gs}		—	4.4	—	nC
		Q_{gd}		—	6.7	—	nC
8	电容	C_{ISS}	$V_{\text{DS}}=-25\text{V}, V_{\text{GS}}=0\text{V},$ $f=1.0\text{MHz}$	—	945	—	pF
		C_{OSS}		—	92	—	pF
		C_{RSS}		—	37	—	pF

^a建议阈值电压 8V 以上，导通电阻随阈值电压升高逐渐减小。

7 特性曲线

由于国产芯片的离散性，以下曲线仅供参考，具体使用以实际情况为准。

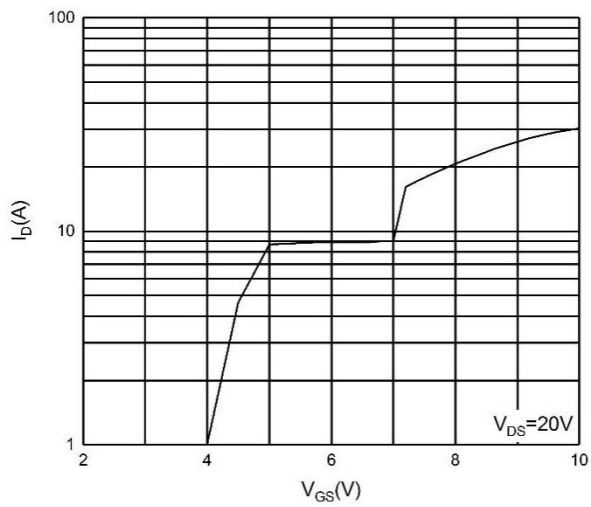


图 1 转移特性曲线

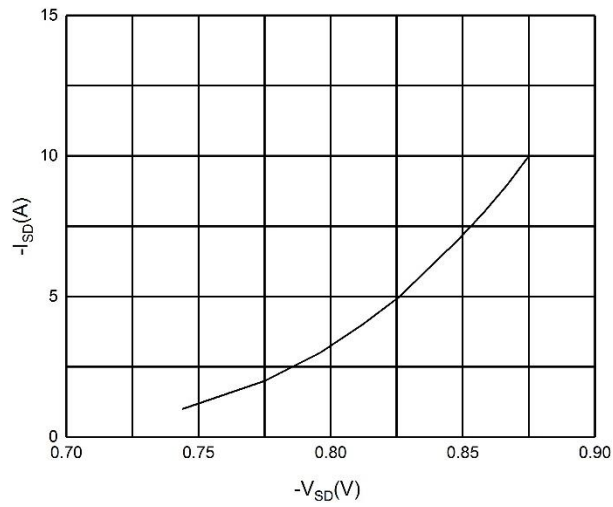


图 2 体二极管特性曲线

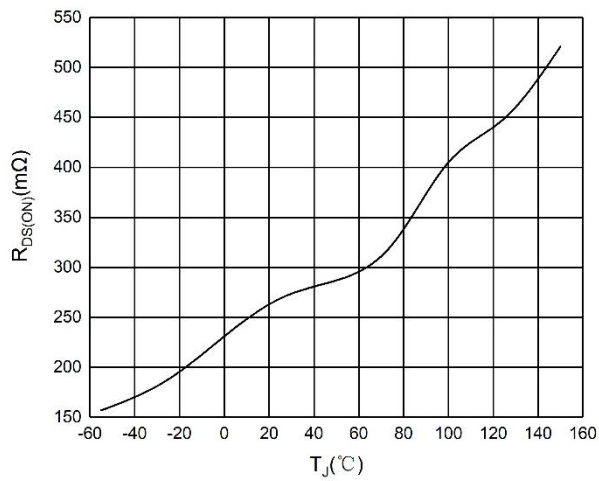


图 3 $R_{DS(on)}-T_J$ 特性曲线

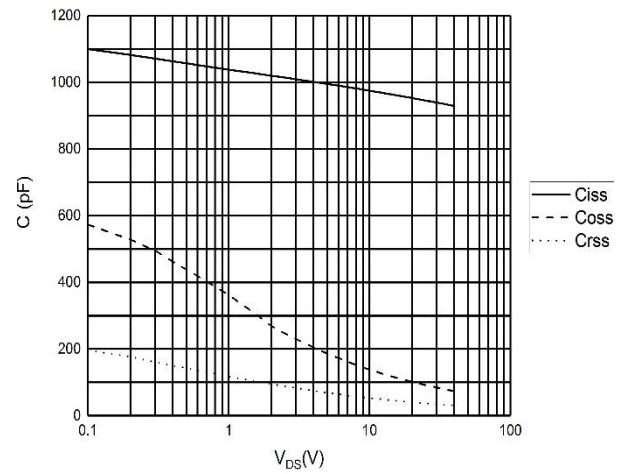


图 4 电容曲线

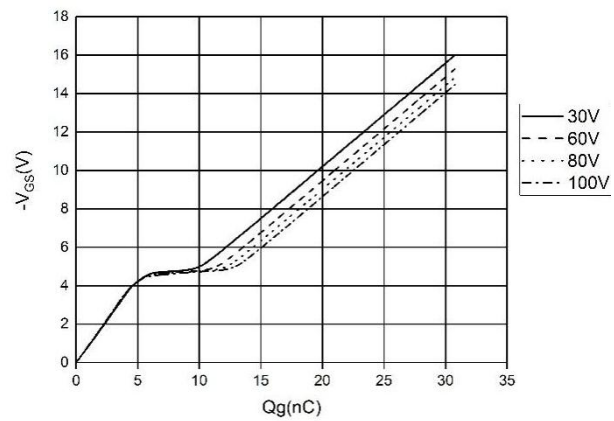
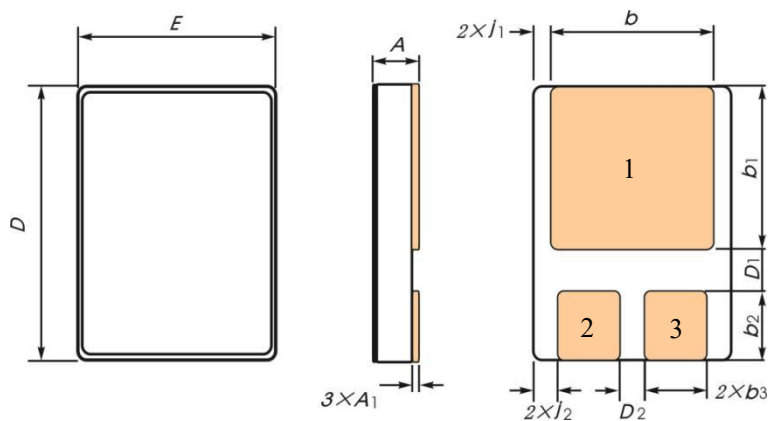


图 5 $V_{GS}-Q_g$ 特性曲线

8 外形尺寸



注：引出端极性（底视图）：1-漏极 D，2-源极 S，3-栅极 G；

单位为毫米

尺寸符号	SMD-0.2	
	数 值	
	最 小	最 大
A	—	3.04
A_1	0.15	0.61
b	4.85	5.35
b_1	4.4	5.1
b_2	1.75	2.15
b_3	1.85	2.25
D	7.77	8.13
D_1	0.5	—
D_2	0.6	—
E	5.23	5.64
j_1	—	—
j_2	—	—

图 7 SMD-0.2 型封装外形尺寸

9 典型应用

该产品为单极型的电压控制器件，在电子线路中主要起开关或放大作用，典型的开关电路如图 8。

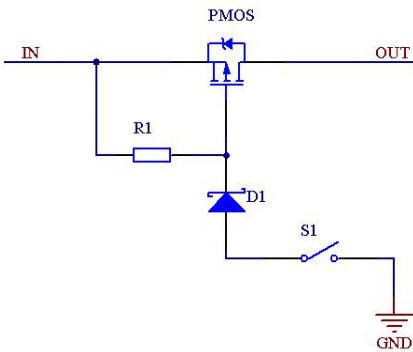


图 8 典型开关电路

10 注意事项

产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获

取产品手册的最新版本，对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

10.1 降额设计

- a) 线路设计应保证与额定值比有足够的余量；
- b) 器件使用时最大结温不超过 150°C ，环境温度不超过 $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 。

10.2 产品使用和防护

- a) 器件应在防静电的工作台上操作；
- b) 试验设备和器具应接地；
- c) 不能直接用手触摸器件引线，应佩戴防静电指套和腕带；
- d) 器件的存放、生产、测试、使用及流转过程工作区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

10.3 产品焊接

镀金引线或焊端均应进行除金处理，不允许在镀金引线或者焊端上直接焊接。可以使用手工焊接、回流焊接两种焊接方式，手工焊接温度不超过 260°C ，焊接时间不超过 10s。使用回流焊炉推荐使用约 183°C 的低熔点焊料焊接，在保证焊接质量的情况下，峰值温度可以适当降低，典型的回流焊接温度工艺曲线如图所示。

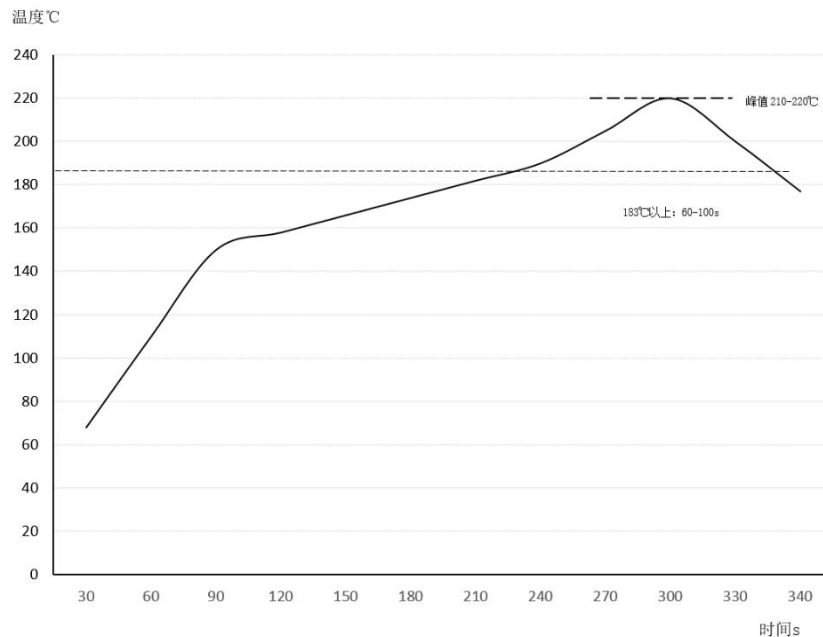


图 9 建议的回流焊曲线

10.4 产品贮存

应将包装好的产品应贮存在环境温度为 $16^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 30%~70%，周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体且通风良好的库房里。

11 可能的失效模式

序号	可能的失效模式	失效情况	失效的条件	可能造成产品失效的原因	使用注意事项
1	过应力烧毁	漏源间 PN 结击穿或开路、芯片铝引线粗糙、发黑，严重者熔断	器件引入过高电应力，超出器件安全工作区，引起器件温升过高，造成参数退化或烧毁	设备自激震荡；器件串入高压信号；环境温度升高后，没有采取降温措施	不超过额定值及安全工作区
2	短路	漏源、漏栅和栅源之间短路	器件过电流或者过功率烧毁	过电流应用；过功率应用	不超过额定值及安全工作区
3	开路	漏源开路、栅源开路	过电流导致压焊丝熔断	外部电路振荡引入过大电流	抑制外部电路振荡，保证器件不超过额定值及安全工作区
4	静电损伤	漏源、漏栅和栅源之间短路，漏源开路、栅源开路	器件过电流或者过功率烧毁，过电流导致压焊丝熔断	筛选、测试、安装及运输过程中引入的静电	采取接地等防静电措施

12 生产厂信息

通信地址：济南市长清区平安街道经十西路 13856 号晶恒工业园

技术咨询 电话：0531-87225289 传真：0531-86593255

电话：0531-86593255 传真：0531-86593255

销售业务（华北、东北） 电话：0531-86593275 传真：0531-86990345

销售业务（华东、中南） 电话：0531-86593250 传真：0531-86990345

销售业务（西北、中原） 电话：0531-86593253 传真：0531-86990345

销售业务（西南、华南） 电话：0531-86593150 传真：0531-86990345